PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-198425

(43)Date of publication of application: 18.11.1983

(51)Int.CI.

CO7C 15/56 CO7C 1/34 CO7C 43/215 CO7C 43/225 CO7C 87/62 CO7C 93/14 CO7D209/08 G03G 5/06

(21)Application number: 57-080115

(71)Applicant: RICOH CO LTD

(22)Date of filing:

14.05.1982

(72)Inventor: SASAKI MASAOMI

(54) ALPHA-PHENYLSTILBENE DERIVATIVE AND PREPARATION THEREOF (57)Abstract:

NEW MATERIAL:An α-phenylstibene derivative expressed by formula I {A is formula II or III [(R)m are H, alkyl, alkoxyl, halogen, dialkylamino, aralkylamino or arylamino and may be the same or different when m is ≥ 2; m is an integer 0, 1, 2 or 3], or 9-anthryl or Nalkylcarbazolyl; n is 0 or 1].

EXAMPLE: α-Phenyl-4'-N,N-dimethylaminostilbene. USE: An electrophotographic organic photoconductive material and fluorescent brightener.

PROCESS: A 1,1-diphenylmethyl derivative expressed by formula IV [Y is triphenylphosphonium expressed by formula V (Z- is halogen ion) or a dialkyl phosphite expressed by the formula PO(OR1)2 (R1 is alkyl)] is reacted with an aldehyde compound expressed by formula VI to give the aimed compound expressed by formula I.

(3) C- CH (CH - CH + A)	I
(18) • (3) :	•
(<u>o</u>)	
	Ņ,
© -₽•4©137•	¥
0110401-0113-4	u

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

19日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願介告

許 公 報(B2)

平2-24864

®Int. CI. *

識別記号

庁内整理番号

❷❸公告 平成2年(1990)5月30日

C 09 B 23/00 .

8217-4H

// G 03 G 5/06

3 1 3

6906-2H

発明の数 2 (全19頁)

会発明の名称

αーフエニルスチルベン誘導体及びその製造法

前置審査に係属中

204寺 頤 昭57-80115 窗公 第 昭58-198425

願 昭57(1982)5月14日

❸昭58(1983)11月18日

⑫発

佐々木 正 臣

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

の出 願 人 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

審査官 多参考文献 星野 紹 英

Anorg. Chem., Org. Chem. 34B巻 4号 p. 606-608(1979)

Anorg. Chem., Org. Chem. 30B卷7-8号 p. 513-515(1975)

J. Ind. Chem. Soc., 54巻5号 p. 443-446(1977)

Tetrahedron Lett. 7号 p. 447-450(1975)

1

2

切特許請求の範囲

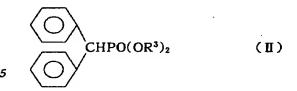
1 一般式(I)

$$C=CH-(CH=CH)_{\overline{n}}A$$
 (1)

(式中Aは
$$(R)_m$$
 R^1 $9-アントリ$ R^2

ル基またはNーアルキルカルパゾリル基を示し、 Rは低級アルキル基、低級アルコキシ基、ハロゲ ンジル基、または無置換あるいは低級アルキル 基、低級アルコキシ基もしくはハロゲン置換のフ エニル基を示し、mは0または1の整数、nは0 または1の整数を示す。)で表わされるαーフエ ニルスチルベン誘導体。

2 一般式(Ⅱ)



(R³は低級アルキル基を示す)で表わされる 1, 1-ジフエニルメチル誘導体と次の一般式 (II)

OHC-(CH=CH)-n A (国) (式中Aは
$$(R)_m$$
 $(R)_m$ $(R)_m$

ン原子を示し、R'及びR'は低級アルキル基、ペ 15 ル基またはN-アルキルカルパゾリル基を示し、 Rは低級アルキル基、低級アルコキシ基、ハロゲ ン原子を示し、R'及びR'は低級アルキル基、ベ ンジル基、または無置換あるいは低級アルキル 基、低級アルコキシ基もしくはハロゲン置換のフ 20 エニル基を示し、mは0または1の整数、nは0 または1の整数を示す。)で表わされるアルデヒ ド化合物とを反応させることを特徴とする次の一 般式(I)

$$C=CH-(CH=CH)_{\overline{n}}A \qquad (1)$$

(式中Aおよび n は上記で定義したとおりであ る。) で表わされるαーフエニルスチルベン誘導 体の製造法。

発明の詳細な説明

本発明は新規なαーフエニルスチルベン誘導体 及びその製造法に関する。

本発明のαーフエニルスチルベン誘導体は、電 子写真用の有機光導電性素材及び螢光増白剤とし 子写真用の有機光導電性材料として有用である。

従来、電子写真方式において使用される感光体 の有機光導電性素材としてポリーNービニルカル バソールをはじめ数多くの材料が提案されてい

ここにいう「電子写真方式」とは一般に光導電 性の感光体をまず、暗所で例えばコロナ放電など により帯電せしめ、ついで露光部のみの電荷を選 択的に放電させる事により静電潜像を得て、この 潜像部をトナーなどを用いた現像手段で可視化し 25 て画像を形成するようにした画像形成法の一つで ある。このような電子写真方式における感光体に 要求される基本的な特性としては、1)暗所にお いて適当な電位に帯電されること、2) 暗所にお ける電荷の放電が少ないこと、3)光照射により 30 速やかに電荷を放電すること、などが挙げられ る。しかし従来の光導電性有機材料はこれらの要 求をかならずしも十分に満足していないのが実状 である。

一方、セレンや酸化亜鉛は光導電性無機材料と 35 して知られており、中でもセレンは広く実用に供 されていることは事実である。しかし最近電子写 真のプロセスの点から、感光体に対する種々の要 求、すなわち一例として前述の基本的特性に加え て、例えばその形状についても可撓性のあるベル 40 ロゲン原子を示し、R¹およびR²は低級アルキシ ト状の感光体などが要求されるようになつて来て いる。しかしセレンの場合は一般にこのような形 状のものに作成することは困難である。

本発明の目的は、上述のような感光体に於ける

光導電性素材のもつ欠点を除去した、殊に光導電 性素材として有用な新規なαーフエニルスチルベ ン誘導体及びその製造法を提供することである。

即ち第1の発明は、一般式(1)

$$C=CH-(CH=CH-)_{\overline{n}}A$$
 (I)

(式中Aは
$$(R)_m$$
 $(R^1, 9-アントリ$ $(R^2, 9-アントリ$

て使用することができる。特に後述するように電 15 ル基またはN-アルキルカルバゾリル基を示し、 Rは低級アルキル基、低級アルコキシ基、ハロゲ ン原子を示し、R'及びR'は低級アルキル基、ベ ンジル基、または無置換あるいは低級アルキル 基、低級アルコキシ基もしくはハロゲン置換のフ 20 エニル基を示し、mは 0 または 1 の整数、 n は 0 または1の整数を示す。)で表わされるαーフエ ニルスチルベン誘導体。

CHPO(OR
3
)₂ (II)

第2の発明は、

(R³は低級アルキル基を示す) で表わされる 1, 1ージフエニルメチル誘導体と

(式中はAは
$$(R)_m$$
 R^1 9-アント

リル基またはNーアルキルカルパゾリル基を示。 し、Rは低級アルキシ基、低級アルコキシ基、ハ 基、ベンジル基、または無置換あるいは低級アル キル基、低級アルコキシ基もしくはハロゲン置換 のフエニル基を示し、mは0または1の整数、n は0または1の整数を示す。)で表わされるアル

デヒド化合物とを反応させることを特徴とする次の一般式(I)

$$C=CH-(CH=CH-)_{n}A \qquad (1)$$

(式中Aおよびn は上記で定義したとおりである。) で表わされる α -フェニルスルベン誘導体 10 の製造法である。

本発明で用いる一般式(II)で表わされる1, 1ージフエニルメチル誘導体は、対応するハロメ チル化合物と亜リン酸トリアルキルとを直接ある いはトルエン、キシレン等の溶媒中で加熱するこ 15 とにより容易に製造される。ここで亜リン酸トリ アルキルとしては炭素数1~4のアルキル基、特 にメチル基、エチル基が好ましい。

こうして得られた一般式(Ⅱ)で表わされる 1,1-ジフエニルメチル誘導体と一般式(Ⅲ)20 で表わされるアルデヒド化合物とを塩基性触媒の 存在下、室温から100℃程度の温度において反応 させる。

塩基性触媒としては、苛性ソーダ、苛性カリ、ナトリウムアミド、水酸化ナトリウム及びナトリ 25 ウムメチラート、カリウムー t ープトキサイドなどのアルコラートを挙げることができる。また反応溶媒としては、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノール、2ーメトキシエタノール、1,2ージメトキシエタン、ピス(2ーメ 30トキシエチル)エーテル、ジオキサン、テトラヒドロフラン、トルエン、キシレン、ジメチルスルホキシド、N,Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリドン、1,3ージメチルー2ーイミダゾリジノンなどを挙げることができる。中でも35極性溶媒、例えば、N,Nージメチルホルムアミドおよびメチルスルホキシドが好適である。

反応温度は、1)使用する溶媒の塩基性触媒に対する安定性、2)縮合成分〔一般式(Ⅱ)及び(Ⅲ)の化合物〕の反応性、3)前配塩基性触媒 40の溶媒中における縮合剤としての反応性によつて広範囲に選択することができる。例えば極性溶媒を用いる時は、実際には室温から100℃、好ましくは室温から80℃である。しかし、反応時間の短

縮又は活性の低い縮合剤を使用する時は更に高い 温度でもよい。

この様にして得られる本発明にかかわる新規 α ーフエニルスチルベン誘導体を例示すれば次の通 5 りである。

$$C=CH-O-N(CH_3)_2$$

$$C=CH-C_2H_5)_2$$

$$C=CH-CO-N(CH_2CO)_2$$

$$\begin{array}{c} OCH_3 \\ C=CH- \\ \hline \end{array} -N(CH_2 \\ \hline \end{array})_2$$

$$CI$$

$$C=CH-C)-N(CH_2C)_2$$

$$C=CH-O-N+OCH_3)_2$$

$$C=CH$$

$$C_{2}H_{5}$$

$$C=CH-CH=CH-CH_3)_2$$

本発明にかかわる新規αーフエニルスチルベン 誘導体は、電子写真用感光体に於ける光導電性素 材として極めて有用であり、染料やルイス酸など 40 の増感剤によつて光学的あるいは化学的に増感さ れる。また有機顔料あるいは無機顔料を電荷発生 物質とするいわゆる機能力離型感光体に於ける電 荷移動物質としてとりわけ有用である。

上記増感剤として例えばメチルバイオレツト、

30

クリスタルバイオレツト等のトリアリルメタン染 料、ローズベンガル、エリスロシン、ローダミン B等のキサンテン染料、メチレンブルー等のチア ジン染料、2, 4, 7ートリニトロー 9ーフルオ レノン、2, 4-ジニトロー9-フルオレノンが 5 挙げられる。

また有機顔料としては、シーアイピグメントプ ルー25(C.I.No.21180)、シーアイピグメントレツ ド41(C.I.No.21200)、シーアイベーシックレッド 3(C.I.No.45210) 等のアゾ系顔料、シーアイビ 10 グメントブルー16(C.I.No.74100) 等のフタロシ アニン系顔料、シーアイパットブラウン 5(C.1. No.73410)、シーアイパットダイ (C.1.No.73030) 等のインジゴ系顔料、アルゴスカーレツトB、イ ンダンスレンスカーレットR等のペリレン系顔料 15 が挙げられる。又、セレン、セレンーテルル、硫 化カドミウム、αーシリコン等の無機顔料も使用・ できる。

次に実施例により本発明を更に詳細に説明す る。

実施例 1

1, 1-ジフエニルメチルホスホン酸ジェチル 3.048 (0.010モル) と 4 - N, N-ジメチルア ミノベンズアルデヒド1.49 g (0.010モル)を1.水素化ナトリウム0.50 g を加えた。室温で3時間 かきまぜを行なつた後、30分加熱還流した。室温 迄放冷した後反応混合物を水200mlに注ぎ、生成 した沈澱物を濾取、水洗乾燥した。収量は2.0%

(収率66.7%)であつた。エタノールから再結晶 し、淡黄色板状結晶のαーフエニルー4'-N. N ージメチルアミノスチルベンの純品を得た。融点 は125.0~125.5℃であつた。

元素分析値はC22H22Nとして下記のとおりであ つた。

	C%	Н%	N% ·
計算値	88.24	7.08	4, 68
実測値	88, 01	7.07	4,76

赤外線吸収スペクトル (KBr錠剤法) を第1 図に示した。

実施例 2~16

実施例1において4-N, N-ジメチルアミノ ベンズアルデヒドの代わりに下記表に示すアルデ ヒドを用いる他は実施例1と同様に操作し、新規 なαーフエニルスチルベン誘導体を得た。結果を 表1に示す。又、実施例4で得られたαーフェニ 20 ルー4'-N, Nージベンジルアミノスチルベンの 赤外線吸収スペクトル (KBr錠剤法) を第2図 に、実施例8で得られた α -フェニルー4'-N, N'ージフエニルアミノスチルベンの赤外線吸収 スペクトル (KBr錠剤法) を第3図に、実施例 2-ジメトキシェタン20mlに加え、これに50% 25 10で得られた 1, 1-ジフェニルー 2-(3-N)ーエチルカルパゾリル) エチレンの赤外線吸収ス ベクトル(KBr錠剤法)を第4図にそれぞれ示

г						
	使用したアルデヒド	ローフエールスチルベン誘導体	题 (C)	元素	元 素 分 析 值(%) 実測值/計算値	首(%) 其值
			(再結晶溶媒)	Ü	Н	Z
. 2	OHC (O)-N(C,H5),	$ \begin{array}{c} \bigcirc \\ C = CH - \bigcirc \\ \bigcirc \\ \bigcirc \end{array} $	94,5~95,5 (11.4/7)	88.01/	7.81/	4.31/
	OHC-CI-N(CH3)1	$ \begin{array}{c c} \bigcirc \\ C=CH-\left\langle \bigcirc \right\rangle -N(CH_3)_t \\ \bigcirc \\ \bigcirc \\ \end{array} $	124,5~126,0 79,05/(エタノール) 79,12	79,05/	5.97/	4.24/
4	OHC-{O}-N(CH ₂ (O)) ₂	$\begin{array}{c} \langle \bigcirc \rangle \\ \downarrow \\ \downarrow \\ \bigcirc \\ \langle \bigcirc \rangle \end{array}$	63.0	90,34/	90,34/6,28/90,41 6,49	3,03/

--- 212 ---

米 施 庭	使用したアルデヒド	αーフエニルスチルベン誘導体	融 (CC)	元素素	元素分析值(実測値/計算値	直(%)
5본			(再結晶溶媒)	၁	Н	z
ω.	OHC \\ \O\\ \O\\ \O\\ \O\\ \O\\ \O\\ \O\	$\begin{array}{c} \bigcirc \\ \bigcirc $	169.0~170.7 (酢酸エチル)	90,01/	6.64/	3.03/
9	OHC \\ O\\-\ \O\\\ OCH_8	$ \begin{pmatrix} \bigcirc \\ \bigcirc \\ C = CH - \langle \bigcirc \rangle - N(CH_2 \langle \bigcirc \rangle)_2 \\ \langle \bigcirc \rangle \\ \langle \bigcirc \rangle \\ \downarrow OCH_3 $	125,0~126,0 87,49/ 6,55/ (リグロイン) 87,27 6,50	87.49/	6.55/	2,74/
7	OHC-{\(\circ\)}_N(CH_\(\circ\))_\(\circ\)	$\left\langle \bigcirc \right\rangle \\ C = CH - \left\langle \bigcirc \right\rangle - N(CH_{2} \left\langle \bigcirc \right\rangle)_{2}$	176.5~178.0 84.13/ (トルエンー 84.00 -n—Hex)	84, 13/	5,72/	2,80/

実施例	使用したアルデヒド	αーフエニルスチルベン誘導体	聚 (C)	元素分表	分析伽山值/計算	(美麗)
. 된			(再結晶溶媒)	Ü	Н	z
®	OHC-(O)-N		92.5~94.5 (ジオキサン ーエクノール)	90, 52/	5, 99/	3, 10/
6	онс О	(O)	169.5~170.5 (エタノール ーシクロヘキ サン)	94.20/ 5.63/	5.63/	
10	OHC O N O	$C=CH$ $C=CH$ $C_{c}H_{s}$	139,5~140,5 90,12/ 6,17/ (トルエンー 90,03 6,22 エタノール)	90, 12/		3,64/

	特公	平 2
1	18	
2.90		
90'9		
84.43		
クロヘキサ		

実施開	使用したアルデヒド	αーフエニルスチルベン誘導体	型 (C) (C)	元業	元素分析值(%) 実測值/計算值	[(%)
조론			(再結晶溶媒)	ပ	Н	z
Ξ	OHC-CH=CH-(O)-N(CH3)2	C=CH-CH=CH-\O\)-N(CH ₃) ₁	171,5~172,5 88,65/ 7,17/ (ジオキサン 88,60 7,14 ーメタノール)	88,65/		4, 32/
12	OHC-{O}-N-{O}-CH ₈) ₂	(O) c=cH-(O)-N4(O)-cH ₃) ₁	139.0~140.0 90.31/ (ジオキサン 90.41 -エタノール)	90,31/	6,50/	3.07/
13	OHC-{\(\)\-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	(O) C=CH-(O)-N-(O)-0CH3);	122.5~124.0 84.51/ 6.10/ シクロヘキサ 84.43 6.06 ン	84, 51/84, 43		3.01/2.90

実施例	使用したアルデヒド	αーフエニルスチルベン誘導体	聚 (C)	元素素	元素分析(実別値/計算	重(%) 算值
:돌			(再結晶溶媒)	٠.	Н	z
14	OHC-(O)-N	OCH ₃ C=CH-\O\-\O\-\O\-\O\-\O\-\O\-\O\-\O\-\O\-\O	122.5~126.5 87.29/ 酢酸エチルー 87.37 エタノール	87.29/ 87.37	5.98/	3.01/
15	OHC-O-N	$\begin{array}{c} \text{CH}_{s} \\ \text{C} \\ \text{C} \\ \text{C} \end{array}$	告 次 多	90, 39/ 6, 18/		3.17/
16	OHC-O-N		年 六 冬	83, 99/ 83, 91	5.31/	3.01/

実施例 17

1, 1-ジフエニルメチルホスホン酸ジエチル 6.50 g (0.021モル) と、4-N, N-ジフエニ ルアミノベンズアルデヒド5.84 9 (0.021モル) をN, N-ジメチルホルムアルデヒド40mlに溶 5 解し、これにカリウムーtープトキサイド2.838 (0.025モル)を21~33℃にて20分を要して添加し た。添加後室温で4時間攪拌を行なつた後、反応 混合物を60mlの氷水に注ぎ生成した沈澱を濾取、 水洗、乾燥し8.20 g (収率90.6%) の粗製品を得 10 た。

次いで、トルエンーエタノール混合溶媒から再 結晶液、得られた淡黄色針状結晶を濾取し、メタ ノールで洗浄した後、乾燥してα-フエニルー* *4'-N, N-ジフエニルアミノスチルベンの純品 を得た。融点は94.0~95.0℃であつた。

元素分析値はCa2H25Nとして下記のとおりであ つた。

	С%	Н%	N%
計算値	90.68	5, 91	3.32
実測値	90,73	5, 96	3.31

赤外線吸収スペクトル (KBr錠剤法) を第5 図に示した。

応用例 1

電荷発生物質として下記構造式の化合物

76部 (重量部、以下同じ)、ポリエステル樹脂 (バイロン200㈱東洋紡績製)の2%テトラヒドロ 部をボールミル中で粉砕混合し、得られた分散液 をアルミニウム蒸着したポリエステルフイルムの アルミニウム面上にドクタープレードを用いて塗 布し、自然乾燥させて厚さ約1µmの電荷発生層を 形成した。

一方、電荷輸送物質として、αーフエニルー 4'-N, N-ジエチルアミノスチルベン 2部、ポ リカーポネート樹脂(パンライトK1300、㈱帝人 製) 2部およびテトラヒドロフラン16部を混合溶

解して溶液とした後、これを前記電荷発生層上に ドクターブレードを用いて塗布し、80℃で2分 フラン溶液1260部およびテトラヒドロフラン3700 25 間、ついで105℃で 5 分間乾燥させ厚さ約20μm の電荷輸送層を形成せしめて感光体No.1を作成 した。

応用例 2~7

2

応用例 1 における α - フエニルー4'-N, N-30 ジエチルアミノスチルベンにかえて、表 2に示し たαーフエニルスチルベン誘導体を用いた以外は 応用例1と同様にして感光体No.2~7を作成し た。

表

感光体Na	αーフエニルスチルベン誘導体
2	$C=CH-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$

感光体Na	αーフエニルスチルベン誘導体
3	C=CH-\(\circ\)
4	C=CH-CH=CH-CH ₃ CH ₃
5	C=CH-\(\) -CH ₃
6	C=CH-O
7	C=CH-ON-ON-C ₂ H ₅

このようにして作成した感光体No.1~7について、市販の静電複写試験装置(川口電機製作所製SP428型)を用いて、-6KVのコロナ放電を20秒間行なつて帯電せしめた後20秒間暗所に放置 40し、その時の表面電位Vpo(ボルト)を測定し、ついでタングステンランプ光を感光体表面の照度が20ルツクスになるように照射して、表面電位がVpoの2分の1になるまでの時間(秒)を求め、

.露光量E1/2 (ルックス・秒) を算出した。その 結果は表3の通りであつた。

麦

感光体Na	Vpo	E1/2
1	-1060	1, 1
2	-1070	1.4

5 6

感光体No.	Vpo	E1/2
3	-1090	0.9
4	- 600	1.0
5	-1130	0.8

4.5

1.5

*ジエチルアミノスチルベンにかえて表4に示す化 合物を用いた以外は応用例1と同様にして比較感 光体No.1~4を作成し、上記の測定と同様にし てVpoおよびE1/2を求めた。その結果は表5の 5 通りであつた。

26

次に、応用例 $1 \sigma_{\alpha} - 7 x = n - 4 - N$, N - *

-1040

- 890

比較感光体Na	化 合 物
1	C=CH-\(\bigcirc\)-OCH3
2	C=CH-\(\)-CH3
. 3	C=CH-\(\bigcirc\)-NO2
4	C=CH-CH=CH-C

麦

5

比較感光体Ma E1/2 Vро 1 -14928, 25

40

比較感光体Na	Vpo	E1/2
2	-1678	測定不能 (光減衰極少)

比較感光体M	Vpo	E1/2
. 3	-1584	測定不能 (光減衰なし)
4	-1430	7, 95

以上のように、本発明の α -フエニルスチルベン誘導体は、特に電子写真感光体において優れた性質を示すものである。

28

図面の簡単な説明

第1図は実施例1で得られた化合物の、第2図は実施例4で得られた化合物の、第3図は実施例8で得られた化合物の、第4図は実施例10で得られた化合物の、第5図は実施例17で得られた化合物の各々の赤外線吸収スペクトル図(KBr錠剤法)である。

